

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 3 区分

【発行日】平成28年4月7日 (2016.4.7)

【公開番号】特開2012-128860(P2012-128860A)

【公開日】平成24年7月5日 (2012.7.5)

【年通号数】公開・登録公報2012-026

【出願番号】特願2011-273503(P2011-273503)

【国際特許分類】

G 0 6 F 21/81 (2013.01)

G 1 1 C 16/02 (2006.01)

G 1 1 C 16/06 (2006.01)

【F I】

G 0 6 F 21/02 1 8 1 A

G 1 1 C 17/00 6 1 1 G

G 1 1 C 17/00 6 0 1 Z

G 1 1 C 17/00 6 3 2 A

【誤訳訂正書】

【提出日】平成28年2月17日 (2016.2.17)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

当該モジュールへの攻撃を検出するための手段と、

攻撃が検出されたときに、不揮発性メモリのセル (1 1 0 、 5 1 0) への書き込み動作を指令するために、プログラミング電圧 (U_p) の印加可能なチャージポンプ (1 2 0) に充電することができる指令手段 (1 3 0) と、

通常の動作の際に電力が供給され、攻撃が検出されたときにのみ前記チャージポンプ (1 2 0) へと電力を供給するように構成されたコンデンサ (1 4 0) とを備えており、

前記コンデンサ (1 4 0) が、攻撃が検出されたときに前記指令手段 (1 3 0) にも電力を供給することを特徴とするモジュール (1 0 0 、 5 0 0 、 6 0 0) 。

【請求項 2】

前記指令手段 (1 3 0) が、フリップフロップ (1 3 2) 及び NOT ゲート (1 3 4) を備えており、前記フリップフロップの出力が、通常の動作においては第 1 のレベルにあり、攻撃が検出されたときに第 2 のレベルにあり、前記第 2 のレベルが、前記書き込み動作の継続時間の全体において高のままであることを特徴とする請求項 1 に記載のモジュール (1 0 0 、 5 0 0 、 6 0 0) 。

【請求項 3】

前記セル (1 1 0) が、ワン・タイム・プログラマブル (OTP) セルであることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のモジュール (1 0 0) 。

【請求項 4】

前記セル (5 1 0) が、EEPROM メモリのセルであることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のモジュール (5 0 0 、 6 0 0) 。

【請求項 5】

制御信号 (SC) を含んでおり、

前記制御信号 (SC) のレベル (NH 、 NB) が前記セル (5 1 0) の書き込み又はブ

ランク状態を表わし、

前記制御信号（ＳＣ）が、攻撃が検出されたときに当該モジュール（５００）の重要信号（ＳＩＶ）を維持するために使用されることを特徴とする請求項４に記載のモジュール（５００）。

【請求項６】

前記重要信号（ＳＩＶ）が、リセット信号、クロック信号、又は当該モジュール（５００）の外部の機器に接続された入力／出力信号の中から選択されることを特徴とする請求項５に記載のモジュール（５００）。

【請求項７】

制御信号（ＳＣ）を含んでおり、

前記制御信号（ＳＣ）のレベル（ＮＨ、ＮＢ）が前記セル（５１０）の書き込み又はブランク状態を表わし、

前記制御信号（ＳＣ）が、当該モジュールの重要部品（１５０）への電力の供給を制御するスイッチ（Ｔ３）に対する指令に使用されることを特徴とする請求項４に記載のモジュール（６００）。

【請求項８】

前記スイッチ（Ｔ３）が、ＰＭＯＳトランジスタであることを特徴とする請求項７に記載のモジュール（６００）。

【請求項９】

前記重要部品が、プロセッサ（１５０）であることを特徴とする請求項７に記載のモジュール（６００）。

【請求項１０】

ISO 7816規格によるマイクロ回路カードで構成される請求項１に記載のモジュール（１００、５００、６００）。